

光刻胶 NR9 500PY 赛米莱德 光刻胶

产品名称	光刻胶 NR9 500PY 赛米莱德 光刻胶
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶

光刻胶组分及功能

光引发剂

光引发剂吸收光能（辐射能）后经激发生成活性中间体，并进一步引发聚合反应或其他化学反应，光刻胶 NR9-500PY，是光刻胶的关键组分，光刻胶 NR9-3000PY，对光刻胶的感光度、分辨率等起决定性作用。

树脂

光刻胶的基本骨架，是其中占比较大的组分，光刻胶 NR9-500PS，主要决定曝光后光刻胶的基本性能，包括硬度、柔韧性、附着力、曝光前后对溶剂溶解度的变化程度、光学性能、耐老化性、耐蚀刻性、热稳定性等。

溶剂

溶解各组分，是后续聚合反应的介质，另外可调节成膜。

单体

含有可聚合官能团的小分子，也称之为活性稀释剂，一般参加光固化反应，可降低光固化体系粘度并调节光固化材料的各种性能。

光刻胶的曝光波长由宽谱紫外向g线 i线 KrF ArF EUV(13.5nm)的方向移动。随着曝光波长的缩短，光刻胶所能达到的极限分辨率不断提高，光刻得到的线路图案精密度更佳，而对应的光刻胶的价格也更高。

光刻光路的设计，有利于进一步提升数值孔径，随着技术的发展，数值孔径由0.35发展到大于1。相关技术的发展也对光刻胶及其配套产品的性能要求变得愈发严格。

工艺系数从0.8变到0.4，其数值与光刻胶的产品质量有关。结合双掩膜和双刻蚀等技术，现有光刻技术使得我们能够用193nm的激光完成10nm工艺的光刻。

为了实现7nm、5nm制程，传统光刻技术遇到瓶颈，EUV(13.5nm)光刻技术呼之欲出，台积电、三星也在相关领域进行布局。EUV光刻光路基于反射设计，不同于上一代的折射，其所需光刻胶主要以无机光刻胶为主，如金属氧化物光刻胶。

光刻工艺主要性一

光刻胶不仅具有纯度要求高、工艺复杂等特征，还需要相应光刻机与之配对调试。一般情况下，一个芯片在制造过程中需要进行10~50道光刻过程，由于基板不同、分辨率要求不同、蚀刻方式不同等，不同的光刻过程对光刻胶的具体要求也不一样，即使类似的光刻过程，不同的厂商也会有不同的要求。

针对不同应用需求，光刻胶的品种非常多，这些差异主要通过调整光刻胶的配方来实现。因此，光刻胶，通过调整光刻胶的配方，满足差异化的应用需求，是光刻胶制造商最核心的技术。

此外，由于光刻加工分辨率直接关系到芯片特征尺寸大小，而光刻胶的性能关系到光刻分辨率的大小。限制光刻分辨率的是光的干涉和衍射效应。光刻分辨率与曝光波长、数值孔径和工艺系数相关。

光刻胶 NR9-500PY?-赛米莱德-光刻胶 由北京赛米莱德贸易有限公司提供。
北京赛米莱德贸易有限公司 (www.semild.com) 是北京 大兴区 ,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛米莱德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛米莱德更加美好的未来。